

Фотоприемники

Фотоприемники

— полупроводниковые приборы, регистрирующие оптическое излучение и преобразующие оптический сигнал на входе в электрический сигнал на выходе фотодетектора.

Статистические Параметры фотоприемников:

- Если на выходе фотоприемника изменяется ток, то фотоприемник характеризуется токовой чувствительностью S_i . Токовая чувствительность – величина, характеризующая изменение тока, снимаемого с фотоприемника при единичном изменении мощности падающего оптического излучения:

$$S_i = \frac{\Delta I}{\Delta P} \left[\frac{B}{B_T} \right]$$

- Если регистрируемый сигнал на выходе фотоприемника - напряжение, то вводят понятие вольтовая чувствительность – как величина, показывающая, на сколько изменится напряжение на выходе фотоприемника, при единичном изменении мощности падающего лучистого потока:

$$S_V = \frac{\Delta U}{\Delta P} \left[\frac{B}{B_T} \right]$$

К фотоприемникам относятся:

- **Фотодиоды**
- **Фоторезисторы**
- **Фототранзисторы**
- **P-I-N Фотодиоды**
- **и др. типы**

Процессы лежащие в основе действия фотоприемников:

- **Генерация** носителей под действием внешнего излучения.
- **Перенос** носителей и умножение за счет того или иного механизма, характерного для данного прибора.
- **Взаимодействие** тока с внешней цепью, обеспечивающее получение выходного сигнала.

Фотодетекторы должны обладать

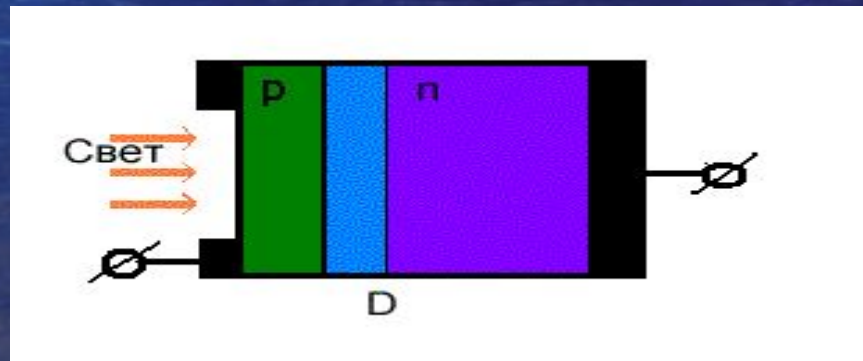
- высокой чувствительностью и быстродействием
- низким уровнем шумов
- иметь малые размеры
- низкие управляющие напряжения и токи.

Фотодиоды

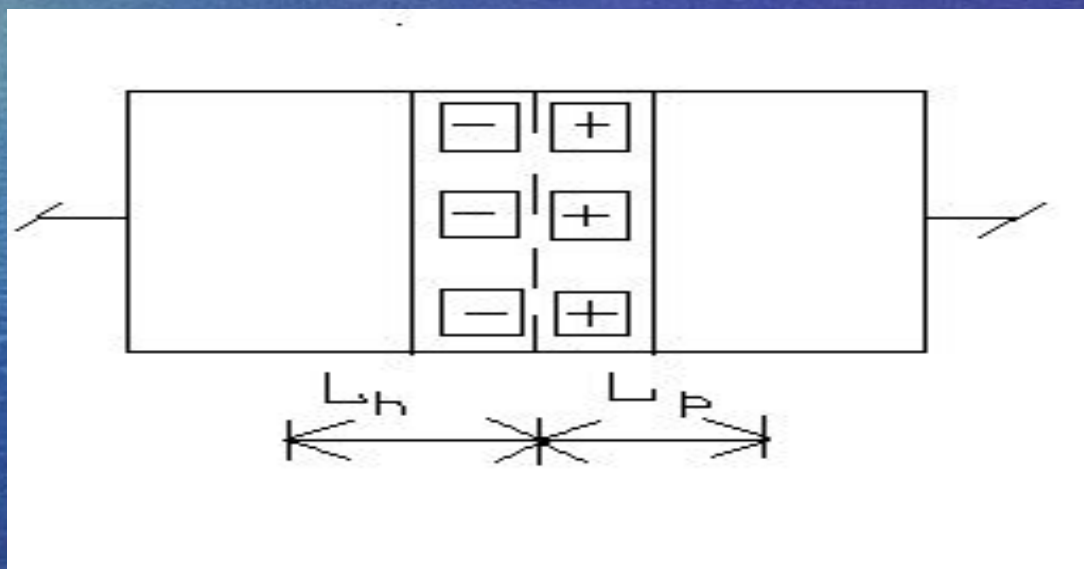
Принцип действия:

под действием оптического излучения образуется электронно-дырочная пара и в области пространственного заряда р-n перехода резко возрастает обратный ток фотодиода.

Схема фотодиода:

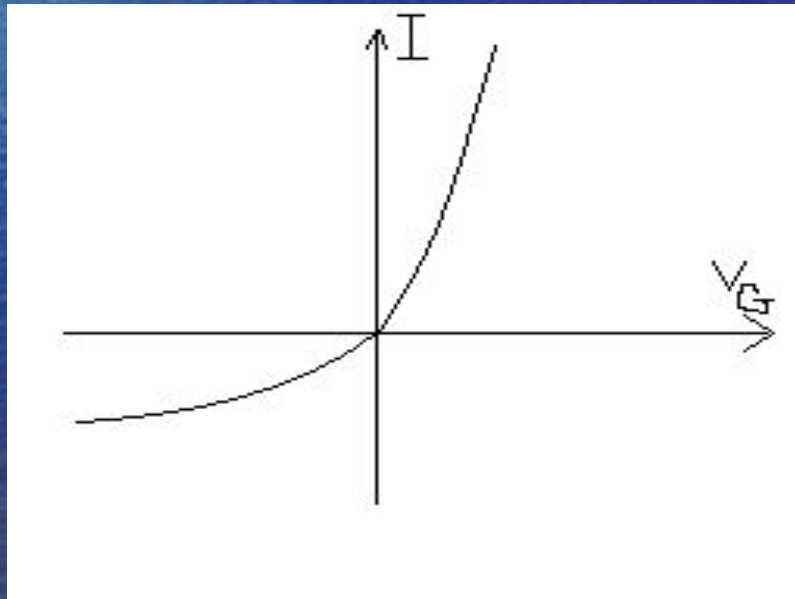


Рассмотрим фотодиод на основе р-п перехода



ВАХ фотодиода

- $I_{\text{темн}} = I_o (e^{\beta V_g} - 1)$
- $I_o = q \cdot L_p \cdot Pn_o / t_p + q \cdot L_n \cdot Np_o / t_n$



$$\Delta N, \Delta P \gg P_{n_0}, N_{p_0}$$

- При освещении фотодиода происходит генерация электронно-дырочных пар. Во всем проводнике изменяется концентрация неосновных носителей, следовательно возрастает дрейфовая компонента тока, а диффузионная не меняется.

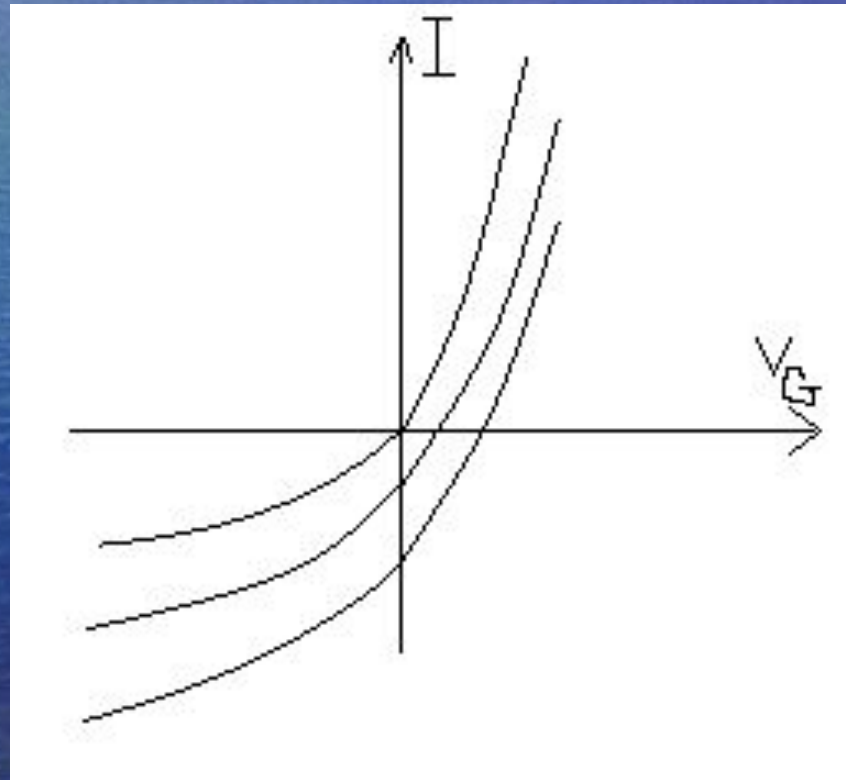
$$\Delta N, \Delta P \gg P_{n_0}, N_{p_0}$$

$$\Delta N, \Delta P \ll N_{n_0}, P_{p_0}$$

$$I_{\phi} = q \cdot L_p \cdot \Delta P / t_p + q \cdot L_n \cdot \Delta N / t_n = I_{\Delta PE} + I_{\Delta NE}$$

Полный ток в фотодиоде

- $I = I_{\Phi} + I_{\text{темн}}$
- Фототок от напряжения не зависит.
- Область поглощения светового потока должна принадлежать промежутку $(-L_{p,n}; L_{p,n})$
- ВАХ сдвигаются эквидистантно.



Расчет полного тока

$$I = I_r + I_n + I_p = I_t + I_\phi$$

I_n - обусловлена равновесными и избыточными электронами в p-области

I_r - обусловлена термо- и фотогенерацией электронно-дырочных пар в области пространственного заряда p-n перехода

I_p - обусловлена дырками в n-области

I_t - плотность темнового тока

I_ϕ - добавка за счет действия оптического излучения

Вклад в **I_n** и **I_p** дают те носители, которые не рекомбинируют с основными носителями и достигают за счет диффузии p-n перехода.

Фоторезистор

- **Фоторезистор** - это пластина полупроводника, на противоположных концах которого расположены омические контакты.
- **Схема фоторезистора:**



Поток внутри полупроводника:

$$\Phi(x) = \Phi_0(1-R)\exp(-\alpha x)$$

Φ_0 - падающий поток

R - коэффициент отражения

α - коэффициент поглощения

$$n_{\phi\pi} = \frac{\alpha \cdot \Phi_0 \cdot (1 - R) e^{-\alpha x}}{S_{\phi} \cdot h\nu}$$

S_{ϕ} - площадь

Работа фоторезистора характеризуется:

1. Квантовой эффективностью (усиление)

Поскольку концентрация изменяется по закону:

$$N = N_0 \cdot \exp(-t/T)$$

где T - время релаксации, то коэффициент усиления по току выражается:

$$I_p/I_{ph} = M_n \cdot T \cdot E/L = T/t_p$$

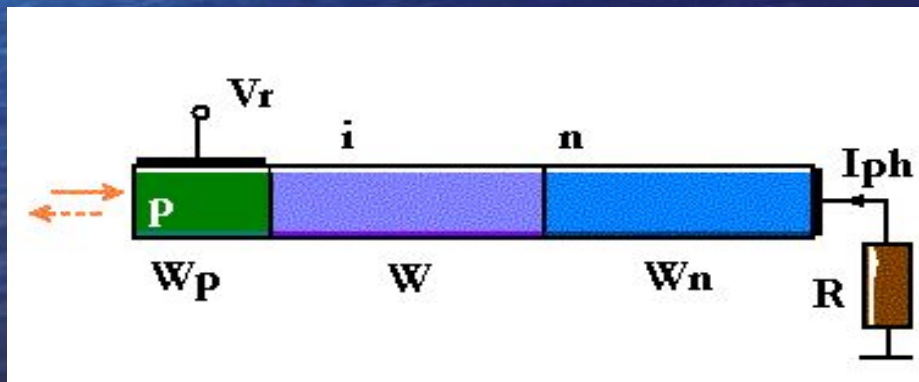
$$t_p = L/V_{др} \text{ — время пролета}$$

2. Время фотоответа: зависит от времени пролета. Обычно у фоторезистора время ответа больше, чем у фотодиода, поскольку между контактами большое расстояние и слабое электрическое поле.

3. Обнаружительная способность.

P-I-N Фотодиод

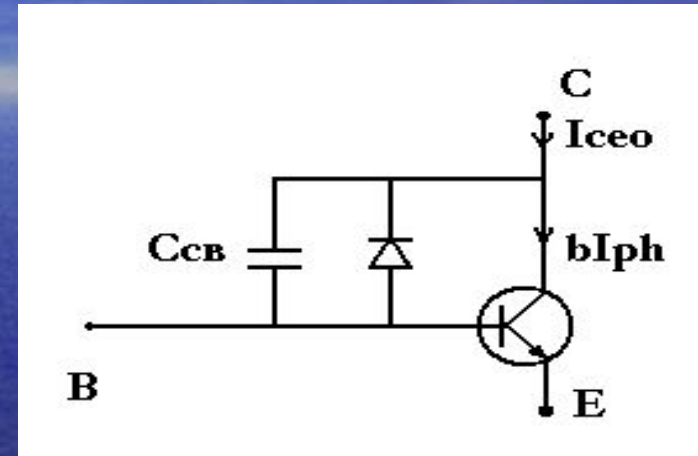
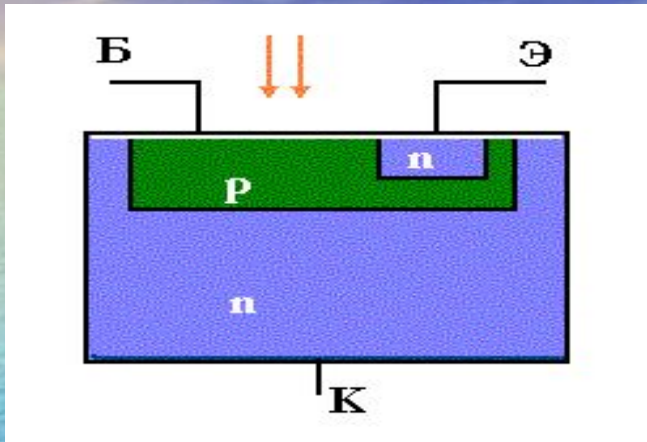
- **P-I-N Фотодиод** построен на обычном p-i-n диоде. Эти приборы являются наиболее распространенными, так как толщину обедненной области можно сделать такой, что обеспечивается оптимальная квантовая эффективность и быстродействие.



Фототранзистор

Фототранзистор действует также как и остальные фотодетекторы, однако транзисторный эффект обеспечивает усиление фототока. По сравнению с фотодиодом фототранзистор более сложен в изготовлении и уступает ему в быстродействии (из-за большей площади).

Устройство и эквивалентная схема:



Переход база - коллектор играет роль чувствительного элемента. На рисунке он показан в виде диода с параллельно включенной емкостью, имеет большую площадь

- Фототранзистор особенно эффективен, так как обеспечивает высокий коэффициент преобразования по току (50% и более). В режиме работы с плавающей базой фотоносители дают вклад в ток коллектора в виде фототока **I_{ph}** . Кроме того, дырки фотогенерируемые в базе, приходящие в базу из коллектора, уменьшают разность потенциалов между собой и эмиттером, что приводит к инжекции электронов через базу в коллектор.
- Общий ток:

$$J_{ceo} = J_{ph} + h_{FE} * J_{ph}$$

Другие виды фотоприемников

На барьере Шоттки

В области пространственного заряда диода с барьером Шоттки на основе полупроводника n-типа при обратном смещении генерируемые электронно - дырочные пары разделяются электрическим полем, и дырки выбрасываются в металлический контакт, а электроны - в базу. Так как ОПЗ имеет малую ширину и примыкает к светоприемной поверхности, то такие фотодиоды обладают высокой квантовой эффективностью и высоким коэффициентом поглощения в области малых длин волн. Оптическое излучение полностью поглощается в ОПЗ фотодиода.

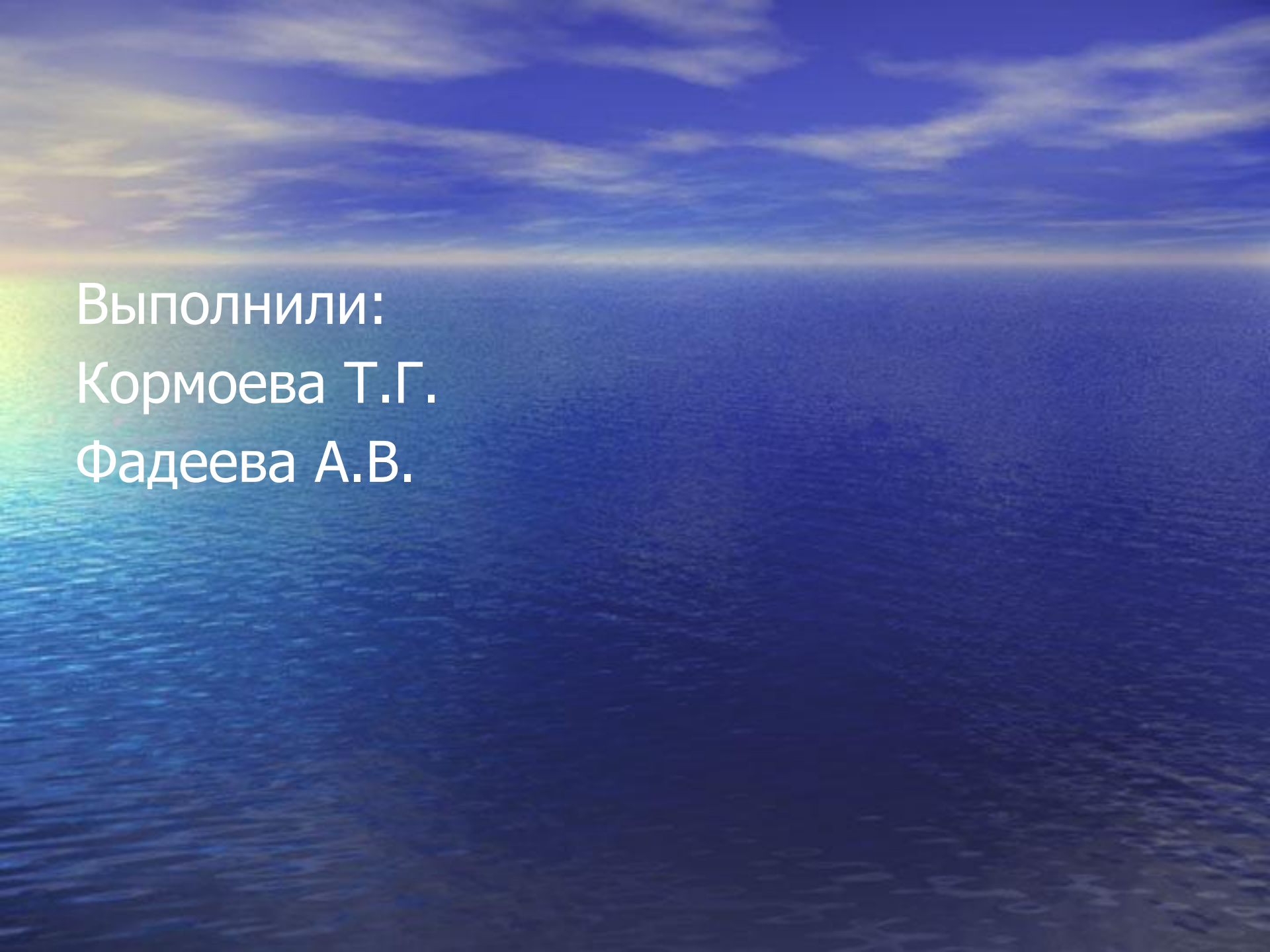
На гетеропереходах

Полупроводник с более широкой запрещенной зоной используется как окно, которое пропускает оптическое излучение с энергией, меньшей чем ширина запрещенной зоны без заметного поглощения. И тогда эффективность фотодиода будет зависеть только от того, на каком расстоянии расположен р-п переход от светоприемной поверхности.

Важно использовать гетеропереход с малой величиной обратного темнового тока, которую можно обеспечить, сводя к минимуму плотность граничных состояний, ответственных за появление, например, части тока, обусловленной фотогенерацией электронно-дырочных пар в ОПЗ р-п перехода. Это обеспечивается за счет согласования постоянных решеток обоих полупроводников

Лавинные фотодиоды

На них подается обратное напряжение, достаточное для развития ударной ионизации в ОПЗ, то есть, сила фототока, квантовый выход и чувствительность возрастают в M раз (M - коэффициент лавинного умножения). Преимущество заключается в том, что они имеют меньшее значение мощности, эквивалентной шуму.



Выполнили:
Кормоева Т.Г.
Фадеева А.В.